

平成 22 年 4 月 12 日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 田島 道夫

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会
第 122 回研究会 開催通知

日時： 2010 年 5 月 19 日 (水) 13:00 ~ 17:05
会場： 明治大学 駿河台キャンパス アカデミーコモン A4 会議室
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
東京都千代田区神田駿河台 1-1 (TEL 03-3296-4545)
JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分
東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩 5 分
都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩 5 分

テーマ 「SiC プロセス技術の進展」－ SiC パワーデバイスの量産化に向けて －

世話人：大谷 昇 (関西学院大学)、西澤伸一 (産業技術総合研究所)
木本恒暢 (京都大学)、伊藤久義 (日本原子力研究開発機構)

プログラム

- 13:00~13:05 開会の挨拶 田島道夫
- 13:05~13:10 はじめに 大谷 昇
- 13:10~13:45 「SiC 単結晶液相成長技術の現状と動向」
亀井一人、楠一彦、矢代将斉、岡田信宏 (住友金属工業(株)総合技術研究所)
- 13:45~14:20 「パワー半導体用 SiC エピタキシャルウェハの開発動向」
佐藤貴幸 (昭和電工(株))
- 14:20~14:55 「高硬度脆性材料のマルチワイヤーソー切断」
前田弘人、吉田 寿、狩田祥行 (株)タカトリ
- 14:55~15:15 休憩
- 15:15~15:50 「SiC 単結晶の放電加工技術の現状と展望」
加藤智久 (産業技術総合研究所先進パワーエレクトロニクス研究センター)
- 15:50~16:25 「SiC パワーデバイス向け高温イオン注入装置及び活性化アニール装置の開発」
清水三郎¹、横尾秀和²、大庭昌俊² (株)アルバック¹半導体電子技術研究所、²電子機器事業部)
- 16:25~17:00 「SiC MOSFET の現状と課題」
矢野裕司 (奈良先端科学技術大学院大学)
- 17:00~17:05 おわりに 西澤伸一
- 17:05~17:25 委員総会
- 17:40~19:40 懇親会 (場所：明治大学駿河台キャンパス リバティータワー23 階 サロン燦)
以上